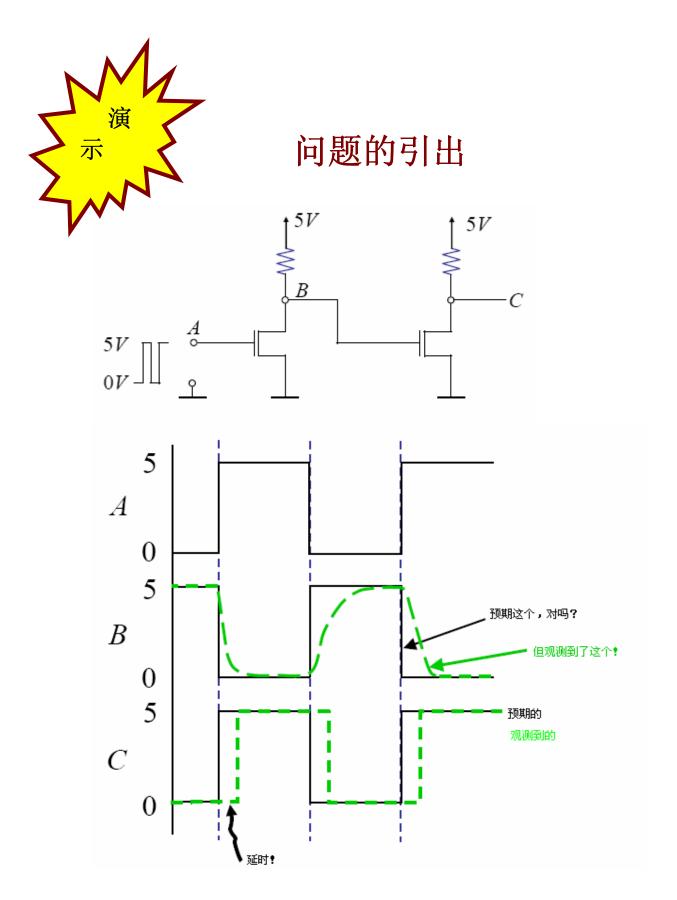
6.002 电路与电子学

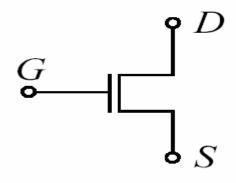
电容器与一阶系统



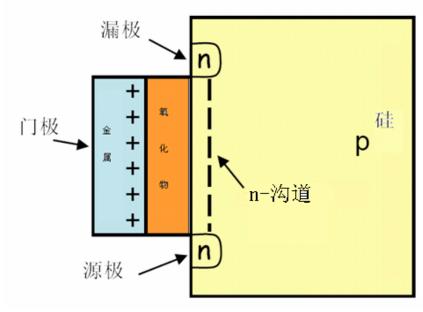
阅读: 第 9 和 10 章

6.002 2000 年秋 第十二

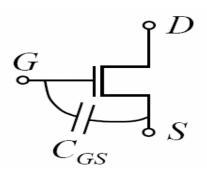
电容器



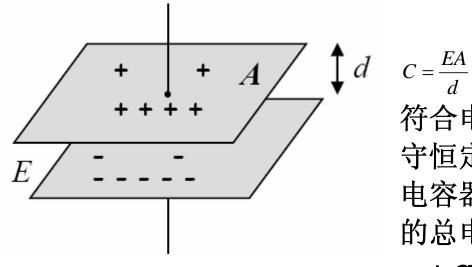
N 沟道 MOSFET 符号



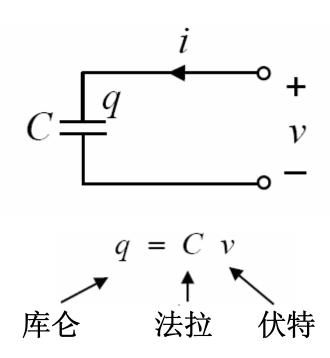
N沟道MOSFET



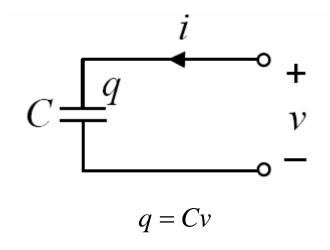
理想线性电容器



 $C = \frac{EA}{d}$ 符合电荷 守恒定律 电容器上 的总电荷 = + \mathbf{q} - \mathbf{q} = $\mathbf{0}$



理想线性电容器

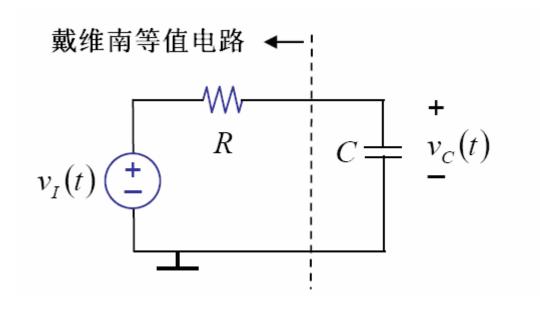


$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(Cv)}{dt} = C\frac{dv}{dt}$$

$$\left[E = \frac{1}{2}Cv^2 \right]$$

一个电容器就是一个能量储存装置 ——〉记忆装置——〉历史的载体!

分析一个 RC 电路



应用节点法:

$$\frac{v_C - v_I}{R} + C \frac{dv_C}{dt} = 0$$

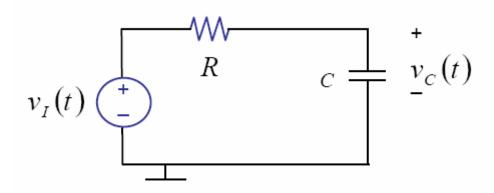
$$RC \frac{dv_c}{dt} + v_C = v_I$$

$$\begin{cases} t \geq t_0 \\ v_C(t_0) \geq \mathfrak{A} \end{cases}$$

其中: RC----时间常数

6.002 2000 年秋 第十二

让我们来做一个例题:



$$v_I(t) = V_I$$
$$v_C(0) = V_0$$
 已知

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V_I$$

例题……

$$v_I(t) = V_I$$
 $v_C(0) = V_0$ 已知
 $RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V_I$ \bigcirc
 $V_C(t) = V_{CH}(t) + V_{CP}(t)$
通解 齐次解 特解

齐次解和特解的求解办法:

- ① 找到特解; ② 找到齐次解; ③ 通解即特解与齐次解之和; 利用初始条件求出其中余下的常数。

①特解

$$RC \frac{dv_{CP}}{dt} + v_{CP} = V_I$$

$$v_{CP} = V_I$$
 正常工作时

$$v_{CP} = V_I$$
 正常工作时

$$RC\int_{0}^{dV_{I}} + V_{I} = V_{I}$$

通常,利用试误法(或:尝试法)。

VCP: 任何满足原始方程式(X)的解。

2 齐次解

$$RC\frac{dv_{CH}}{dt} + v_{CH} = 0$$

V_{CH}: 齐次方程[♥]的解 (令激励源等于零)

 $v_{CH} = Ae^{st}$ 假想的解的形式。

A, S 呢?

$$RC\frac{dAe^{st}}{dt} + Ae^{st} = 0$$

$$RCAs^{t}e+As^{t}=0$$

消去 e^{st} , 得 RCAs + A = 0

舍去增根 A=0,得

$$RCs + 1 = 0$$
 特征方程

$$s = -\frac{1}{RC}$$

则: $v_{CH} = Ae^{\frac{-t}{RC}}$ 其中: RC———称作时间常数 τ

6.002 2000 年秋 第十二

3通解

$$v_C = v_{CP} + v_{CH}$$
$$v_C = V_I + Ae^{\frac{-t}{RC}}$$

从初始条件中找出余下的未知量:

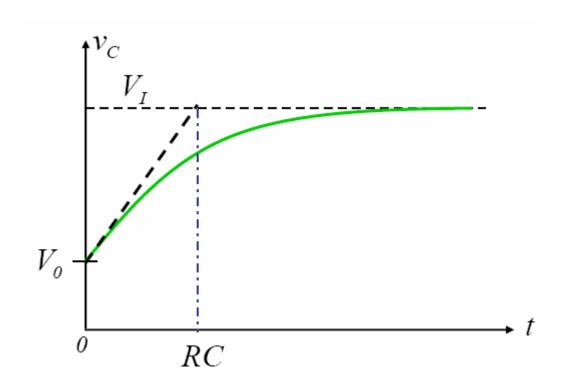
假定
$$t=0$$
 时 $v_C=V_0$,
 $X_0=V_I+A$

或者 $A=V_0-V_I$

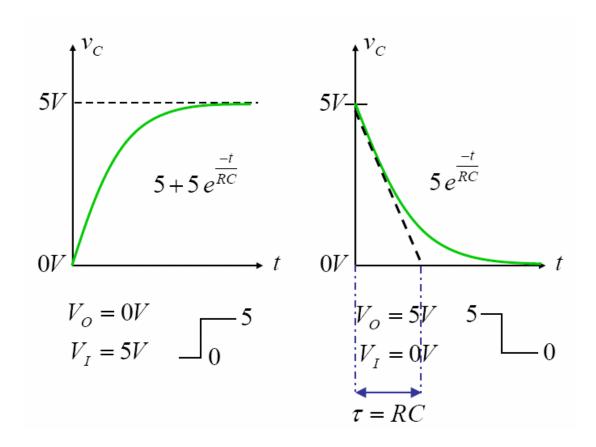
因此 $V_C=V_I+(V_0-V_I) e^{\frac{-t}{RC}}$

而且
$$i_C = C \frac{dv_C}{dt} = -\frac{(V_0 - V_I)}{R} e^{\frac{-t}{RC}}$$

$$v_C = V_I + \left(V_0 - V_I\right) e^{\frac{-t}{RC}}$$



例题



记住演示

